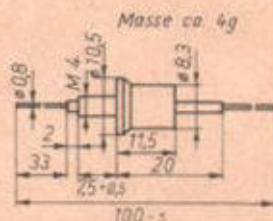


SZ 501...SZ 510 Silizium-Leistungszenerdioden



KENNWERTE ($\theta_a = 25^\circ\text{C} - 5^\circ\text{grd}$)

[illegible]ZULÄSSIGE HÖCHST- UND MINDESTWERTE ($\dot{\theta}_B = 45^\circ\text{C}$)

Durchflußstrom	I_{Fmax}	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	mA
	I_{Fmin}	20									
Zenerstrom	$I_{Zmax}^{1)}$		175	160	145	130	115	110	100	90	mA
	$I_{Zmax}^{2)}$		1400	1290	1170	1060	980	880	800	730	mA
	I_{Zmin}		10	10	10	10	10	10	10	10	mA
Sperrschichttemperatur	θ_j					155					°C
Umgebungstemperatur	θ_a				-55 ... +125						°C
Wärmewiderstand	R_{thi}					8					grd/W
	R_{th}					80					grd/W

* In Durchlaßrichtung gepolte Diode 1) Ohne Kühlblech 2) Mit vertikalem Kühlblech

SZ 501...SZ 522

Bestellbezeichnung einer Silizium-Leistungszenodiode mit einer Zenerspannung $U_Z = 8\text{ V}$ – Silizium-Leistungszenodiode SZ 508

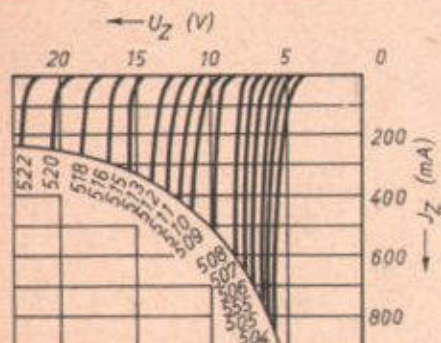


Abb. 36

Mittlere Kennlinien
(für $\theta_a = 25^\circ\text{C}$)

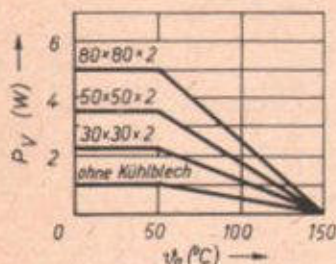


Abb. 37 Reduzierung der
Verlustleistung

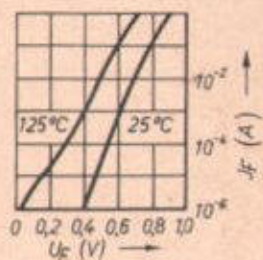


Abb. 38

Mittlere Durchlaßkennlinie
bei 25°C und
 125°C Um-
gebungs-
temperatur

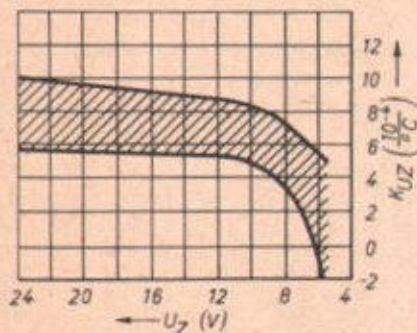


Abb. 39

Streubereich der Temperatur-Beiwerte K_{UZ} der Zenerspannung U_Z in Abhängigkeit von U_Z bei $I_Z = 100\text{ mA}$

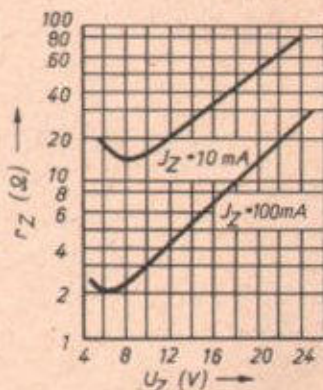


Abb. 40

Zenerwiderstand r_Z (Maximale Werte) in Abhängigkeit von der Zenerspannung U_Z bei 25°C Umgebungstemperatur